



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20110204002
2011 年 2 月 17 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

HPA TI-DFABサイト製造 LBC3Sプロセス 一部製品 Wafer径変更予定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての一次予定の連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、変更前の製品サンプル作製は行わない為、変更品評価用サンプルご入用の場合には、事前に本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。変更時期につきましては、次頁以降の変更時期をご参照下さい。お客様の受領連絡及びサンプル依頼は PCN 担当マネージャ或いは担当営業にご連絡下さい。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	■Initial notice (Plan)	□Final notice
変更概要	Design/Specification	□Design □Electrical □Mechanical
	■Wafer Fab	□Site □Process ■Material
	Wafer Bump	□Site □Process □Material
	Assembly	□Site □Process □Material
	Test	□Site □Process
	Others	□Packing/Shipping/Labeling □ -
変更内容	HPA TI-DFAB サイト製造 LBC3S プロセス 一部製品 Wafer 径変更 現行 : Wafer 径: 150 mm 変更後 : Wafer 径: 150 mm, 200 mm	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	5 月下旬の出荷より予定しています。	
品質認定試験	■計画	□終了
製品表示	■変更無し	□変更あり
備考	-	

変更内容

内容：今回のお知らせは、下記変更実施についての一次予定の連絡になります。最終的なお知らせは、弊社内変更審査が終了次第、認定試験の結果を含め、本 PCN の更新版の発行をもって連絡させていただきます。

弊社 HPA (ハイパフォーマンスアナログ) TI-DFAB (Dallas, 米国) サイト製造 LBC3S プロセス 一部製品について、現行 150 mm 径 Wafer を使用して製造していますが、供給能力確保の為に、200 mm 径 Wafer による製造を追加する予定です。TI-DFAB サイトにおいて、LBC3S プロセスの 200 mm 径 Wafer による製造は認定されています。下記信頼性試験結果(2002 年 2 月 22 日終了)を参照下さい。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
Wafer 径	150 mm	150 mm 200 mm

理由：供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
HPA01042DR	SN65HVD11DRG4	SN75HVD10DR	TLV2464CD	TLV24651N
SN65HVD05D	SN65HVD11QD	SN75HVD10DRG4	TLV2464CDG4	TLV24651NE4
SN65HVD05DG4	SN65HVD11QDG4	SN75HVD10P	TLV2464CDR	TLV24651PW
SN65HVD05DR	SN65HVD11QDR	SN75HVD10PE4	TLV2464CDRG4	TLV24651PWG4
SN65HVD05DRG4	SN65HVD12D	SN75HVD11D	TLV2464CN	TLV24651PWR
SN65HVD05P	SN65HVD12DG4	SN75HVD11DG4	TLV2464CNE4	TLV24651PWRG4
SN65HVD05PE4	SN65HVD12DR	SN75HVD11DR	TLV2464CPW	TLV274CD
SN65HVD06D	SN65HVD12DRG4	SN75HVD11DRG4	TLV2464CPWG4	TLV274CDG4
SN65HVD06DG4	SN65HVD12P	SN75HVD12D	TLV2464CPWR	TLV274CDR
SN65HVD06DR	SN65HVD12PE4	SN75HVD12DG4	TLV2464CPWRG4	TLV274CDRG4
SN65HVD06DRG4	SN65HVD230D	SN75HVD12DR	TLV24641D	TLV274CPW
SN65HVD07D	SN65HVD230DG4	SN75HVD12DRG4	TLV24641DG4	TLV274CPWG4
SN65HVD07DG4	SN65HVD230DR	SN75HVD12P	TLV24641DR	TLV274CPWR
SN65HVD07DR	SN65HVD230DRG4	SN75HVD12PE4	TLV24641DRG4	TLV274CPWRG4
SN65HVD07DRG4	SN75HVD05D	TLV23741D	TLV24641N	TLV2741D
SN65HVD07P	SN75HVD05DG4	TLV23741DG4	TLV24641NE4	TLV2741DG4
SN65HVD07PE4	SN75HVD05P	TLV23741DR	TLV24641PW	TLV2741DR
SN65HVD08D	SN75HVD05PE4	TLV23741DRG4	TLV24641PWG4	TLV2741DRG4
SN65HVD08DG4	SN75HVD06D	TLV23741N	TLV24641PWR	TLV2741N

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

SN65HVD08DR	SN75HVD06DG4	TLV2374INE4	TLV2464IPWRG4	TLV274INE4
SN65HVD08DRG4	SN75HVD06DR	TLV2374IPW	TLV2465AIPWR	TLV274IPW
SN65HVD10D	SN75HVD06DRG4	TLV2374IPWG4	TLV2465AIPWRG4	TLV274IPWG4
SN65HVD10DG4	SN75HVD07D	TLV2374IPWR	TLV2465CD	TLV274IPWR
SN65HVD10DR	SN75HVD07DG4	TLV2374IPWRG4	TLV2465CDG4	TLV274IPWRG4
SN65HVD10DRG4	SN75HVD07DR	TLV2464AID	TLV2465CDR	TLV3402CD
SN65HVD10P	SN75HVD07DRG4	TLV2464AIDG4	TLV2465CDRG4	TLV3402CDG4
SN65HVD10PE4	SN75HVD07P	TLV2464AIDR	TLV2465CN	TLV3402CDR
SN65HVD10QD	SN75HVD07PE4	TLV2464AIDRG4	TLV2465CNE4	TLV3402CDRG4
SN65HVD10QDG4	SN75HVD08D	TLV2464AIN	TLV2465CPWR	TLV3402ID
SN65HVD10QDR	SN75HVD08DG4	TLV2464AINE4	TLV2465CPWRG4	TLV3402IDG4
SN65HVD10QDRG4	SN75HVD08DR	TLV2464AIPW	TLV2465ID	TLV3402IDR
SN65HVD11D	SN75HVD08DRG4	TLV2464AIPWG4	TLV2465IDG4	TLV3402IDRG4
SN65HVD11DG4	SN75HVD10D	TLV2464AIPWR	TLV2465IDR	TLV3402IP
SN65HVD11DR	SN75HVD10DG4	TLV2464AIPWRG4	TLV2465IDRG4	TLV3402IPE4

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2011 年 4 月	終了	2011 年 6 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TLV2374ID		SN65HVD11QD	
Wafer Fab Site:	DFAB		DFAB	
Wafer Fab Process:	LBC3S		LBC3S	
Wafer Size:	200 mm		200 mm	
Metallization:	TiW/AlSiCu.5		AlCu(0.5%)	
Passivation:	10KACN		Nitride	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		TLV2374ID	SN65HVD11QD	
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	per spec	-	
Electrical Characterization	To Datasheet parameters	-	per spec	

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	2011 年 4 月	終了	2011 年 6 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TLV3402CDR		-	-
Wafer Fab Site:	DFAB	Wafer Fab Process:	LBC3S	
Wafer Size:	200 mm	Metallization:	TiW/AlSiCu.5	
Passivation:	10KACN		-	-
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size	
Electrical Characterization	Over Temp		10	
ESD CDM	500V		3	
ESD HBM	1000V		3	
Latch-up	-		6	
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification		per spec	

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2011 年 4 月	終了	2011 年 6 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN65HVD05D		SN65HVD07D	
Wafer Fab Site:	DFAB		DFAB	
Wafer Fab Process:	LBC3S		LBC3S	
Wafer Size:	200 mm		200 mm	
Passivation:	Nitride		Nitride	
Metallization:	AlCu(0.5%)		AlCu(0.5%)	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		SN65HVD05D	SN65HVD07D	
Electrical Characterization	To Datasheet parameters	per spec	per spec	
ESD CDM	500V	3	3	
ESD-HBM	2000V	3	3	
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2011 年 4 月	終了	2011 年 6 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN65HVD230D		SN75HVD08D	
Wafer Fab Site:	DFAB		DFAB	
Wafer Fab Process:	LBC3S		LBC3S	
Wafer Size:	200 mm		200 mm	
Metallization:	AlCu(0.5%)		AlCu(0.5%)	
Passivation:	Nitride		Nitride	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		SN65HVD230D	SN75HVD08D	
Electrical Characterization	To Datasheet parameters	per spec	per spec	
ESD CDM	500V	3	3	
ESD-HBM	2000V	3	3	
ESD HBM (Bus Pins)	16000V	3	3	
Latch-up	per JESD78	6	6	
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2002 年 2 月 22 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device:	SN104605PN	Die Protective Coating:	10KACN	
Wafer Fab Site:	DFAB	Wafer Fab Process:	LBC3S	
Wafer Size:	200 mm	Metallization:	TiW/AlCu.5	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Life Test	155C, 1000 Hours	116/0	116/0	116/0
**Biased Hast	130C/85%RH, 96 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
ESD-CDM	500 Volts	3/0	3/0	3/0
ESD-HBM	2500, 3000 Volts	3/0	3/0	3/0
ESD-MM	200 Volts	3/0	3/0	3/0
Bond Strength	-	76/0	76/0	76/0
Die Shear	-	5/0	5/0	5/0
Electrical Characterization	-	Approved	Approved	Approved
Manufacturability (Wafer Fab)	-	Approved	-	-
Manufacturability (Assembly Site)	-	Approved	-	-
Note: ** Preconditioning, JEDEC L-3/220C				